

Сведения об официальном оппоненте

Хохлов Дмитрий Ремович

Электронная почта: khokhlov@mig.phys.msu.ru

Ученая степень: доктор физико-математических наук

Ученое звание: профессор

Специальность: 01.04.10 - физика полупроводников

Академическое звание: член-корреспондент РАН

Место работы

Наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (МГУ имени М.В. Ломоносова)

Ведомственная принадлежность: правительство РФ

Наименование структурного подразделения: физический факультет

Должность: Заведующий кафедрой

Тип организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Субъект РФ: Москва

Город: Москва

Адрес: Москва 119991, Ленинские горы, д.1, стр.2

Список основных публикаций оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет:

1. Galeeva A. V., Egorova S. G., Chernichkin V. I., Ryabova L. I., Danilov S. N., Nicorici A. V., Khokhlov D. R. Magnetic-field-induced terahertz photogeneration in PbTe(Ga) //JETP letters. – 2016. – Т. 104. – С. 68-70. DOI: 10.1134/S0021364016130099 WOS:000385020500013
2. Galeeva A. V., Chernichkin V. I., Dolzhenko D. E., Nicorici A. V., Ryabova L. I., Khokhlov D. R. Optimization of the Operating Regime of Pb_{1-x}Sn_xTe (In) Terahertz Photodetectors //IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. – 2017. – Т. 7. – №. 2. – С. 172-176. DOI: 10.1109/TTHZ.2017.2655880 WOS:000396388900007
3. Galeeva A. V., Artamkin A. I., Mikhailov N. N., Dvoretiskii S. A., Danilov S. N., Ryabova L. I., Khokhlov D. R. Terahertz Photoconductivity in Hg_{1-x}Cd_xTe near the transition from the direct to inverted spectrum //JETP letters. – 2017. – Т. 106. – №. 3. – С. 162-166. DOI: 10.1134/S0021364017150061 WOS:000413066200006
4. Galeeva A. V., Artamkin A. I., Kazakov A. S., Danilov S. N., Dvoretiskiy S. A., Mikhailov N. N., Ryabova L. I., Khokhlov D. R. Non-equilibrium electron transport induced by terahertz radiation in the topological and trivial phases of Hg_{1-x}Cd_xTe //Beilstein journal of nanotechnology. – 2018. – Т. 9. – №. 1. – С. 1035-1039. DOI: 10.3762/bjnano.9.96 WOS:000428707700002
5. Galeeva A. V., Gomanko M. A., Tamm M. E., Yashina L. V., Danilov S. N., Ryabova L. I., Khokhlov D. R. Photoelectromagnetic Effect Induced by Terahertz Radiation in (Bi_{1-x}

- $x\text{Sbx})_2\text{Te}_3$ Topological Insulators // Semiconductors– 2019. – V. 53. – P. 37-41. DOI: 10.1134/S1063782619010068 WOS:000465524600006
6. Drozdov K. A., Krylov I. V., Chizhov A. S., Romyantseva M. N., Ryabova L. I., Khokhlov D. R. Optically Induced Charge Exchange in ZnO-Based Composite Structures with Embedded CsPbBr₃ Nanocrystals // Semiconductors – 2019. – V. 53. – P. 814-818. DOI: 10.1134/S1063782619060058 WOS:000471063300020
 7. Galeeva A. V., Kazakov A. S., Artamkin A. I., Ryabova L. I., Dvoretzky S. A., Mikhailov N. N., Bannikov M. I., Danilov S. N., Khokhlov D. R. Apparent PT-symmetric terahertz photoconductivity in the topological phase of Hg_{1-x}Cd_xTe-based structures // Scientific Reports. – 2020. – V. 10. – P. 2377. DOI: 10.1038/s41598-020-59280-0 WOS:000538418300001
 8. Галеева А.В., Казаков А.С., Артамкин А.И., Дворецкий С.А., Михайлов Н.Н., Банников М.И., Данилов С.Н., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р. Особенности транспорта в топологической фазе Hg_{0.87}Cd_{0.13}Te в условиях терагерцового фотовозбуждения // Физика и техника полупроводников– 2020. – V. 54. – №. 9 – P. 1064-1068. DOI: 10.1134/S1063782620090109 WOS:000567018500012
 9. Kazakov A. S., Galeeva A. V., Artamkin A. I., Ikonnikov A. V., Ryabova L. I., Dvoretzky S. A., Mikhailov N. N., Bannikov M. I., Danilov S. N., Khokhlov D. R. Non-local terahertz photoconductivity in the topological phase of Hg_{1-x}Cd_xTe. // Scientific Reports – 2021. – V. 11. – P. 1587. DOI: 10.1038/s41598-021-81099-6 WOS:000609782400108